

2SB1264

シリコン PNP エピタキシャルプレーナ形

一般増幅用

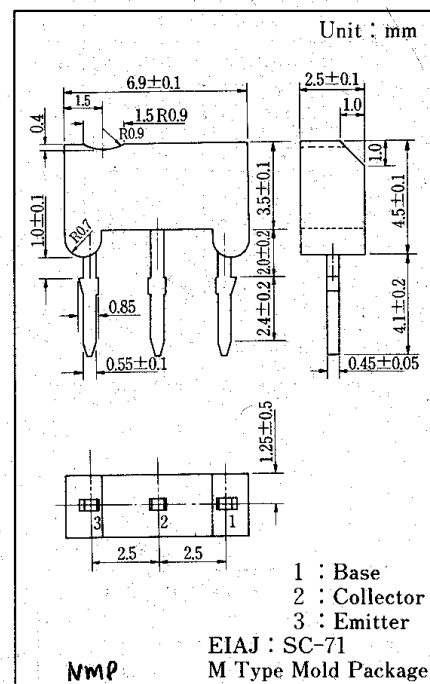
2SD662 とコンプリメンタリ

■ 特 長

- コレクタ・エミッタ電圧 V_{CEO} が高い。

■ 絶対最大定格 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	-250	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	-200	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	-5	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	-100	mA
コレクタ電流	I_C	-70	mA
コレクタ損失	P_C	600	mW
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~+150	$^\circ\text{C}$

■ 電気的特性 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタシャ断電流	I_{CEO}	$V_{CE} = -120\text{V}, I_B = 0$			-1	μA
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C = -100\mu\text{A}, I_B = 0$	-200			V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E = -1\mu\text{A}, I_C = 0$	-5			V
直流電流増幅率	h_{FE}^*	$V_{CE} = -10\text{V}, I_C = -5\text{mA}$	30		220	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -50\text{mA}, I_B = -5\text{mA}$			-1.5	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CB} = -10\text{V}, I_E = 10\text{mA}, f = 200\text{MHz}$	50	80		MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10\text{V}, I_E = 0, f = 1\text{MHz}$			10	pF

* h_{FE} ランク分類

ランク	P	Q	R
h_{FE}	30~100	60~150	100~220